

MOCVD装置 CM-8000



<MOCVD>

上部はガスシャワーになっており、RFプラズマを印加することができます。また下部は800°Cに加熱しながら回転できる基板ホルダーが取り付けられております。フレキシブルな実験ができるMOCVD装置です。

MOCVD装置CM-8000仕様

○膜種	ガス種による
○炉体サイズ	φ400mm×600mm
○炉体材質	SUS316
○基板形状	4インチ 1枚
○到達圧力	×10 ⁻⁴ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄3分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	800°C
○圧力コントロール	自動
○ガス種	選択自由
○電源	RF電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1台
○真空排気系	油回転ポンプ:375L/min メカニカルブースターポンプ:100m ³ /h ターボ分子ポンプ:500L/sec
○真空計	ピラニ真空計/バロトロン真空計
○ユーティリティ	電気:AC200V三相25KVA 冷却水:25L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25°C以下循環 計装エア:0.5MPa以上